

# 2SC2061

www.DataSheet4U.com

## エピタキシャルプレーナリナシリコントランジスタ 中電力増幅用/Medium Power Amp. Epitaxial Planar NPN Silicon Transistor

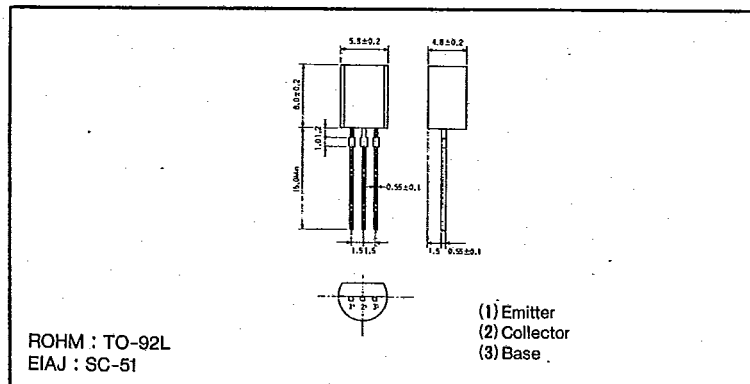
### ● 特長

- 1) 高耐圧である ( $V_{CE0}=80V$ )。
- 2) 大電流である ( $I_C=700mA$ )。

### ● Features

- 1) High breakdown voltage:  $V_{CE0}=80V$
- 2) Large current capacity:  
 $I_C=700mA$

### ● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



### ● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ C$ )

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	80	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	700	mA
		1	A (Pulse) *
コレクタ損失	$P_C$	750	mW
接合部温度	$T_J$	125	$^\circ C$
保存温度範囲	$T_{stg}$	-55~125	$^\circ C$

\*  $P_W=20ms$ , Duty=1/2

### ● 電気的特性/Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ C$ )

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$BV_{CE0}$	80	—	—	V	$I_C=2mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	$BV_{CB0}$	80	—	—	V	$I_C=50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	$BV_{EB0}$	5	—	—	V	$I_E=50\mu A$
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	—	—	0.5	$\mu A$	$V_{CB}=50V$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	—	—	0.5	$\mu A$	$V_{EB}=4V$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	82	—	390	—	$V_{CE}/I_C=3V/100mA$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	0.2	0.4	V	$I_C/I_B=500mA/50mA$
利得帯域幅積	$f_T$	—	120	—	MHz	$V_{CE}=10V$ , $I_E=-50mA$
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	—	10	15	pF	$V_{CB}=10V$ , $I_E=0A$ , $f=1MHz$

$h_{FE}$ の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
$h_{FE}$	82~180	120~270	180~390

### ● 標準品・準標準品一覧表

(◎: 標準品 ○: 準標準品)

Type	$h_{FE}$	包装名	バルク	テーピング
		記号		
		基本発注単位(個)	1 000	2 500
2SC2061	PQR		◎	◎

www.DataSheet4U.com

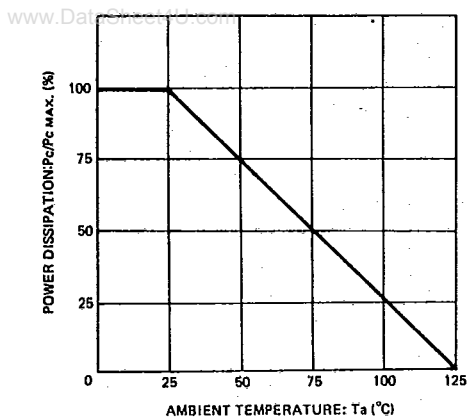


Fig.1 電力軽減曲線

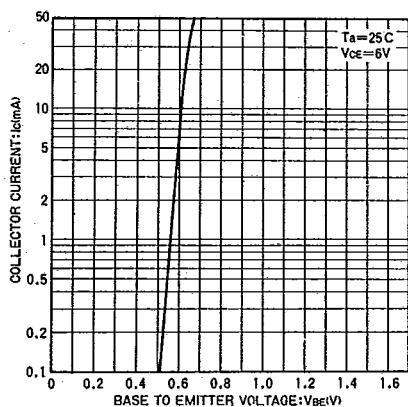


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

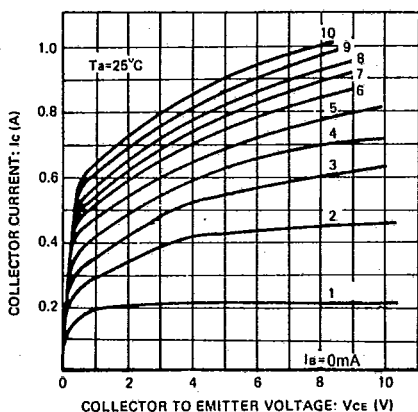


Fig.3 エミッタ接地出力静特性

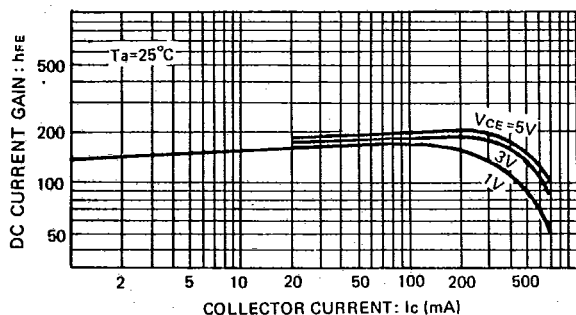


Fig.4 直流電流増幅率—コレクタ電流特性

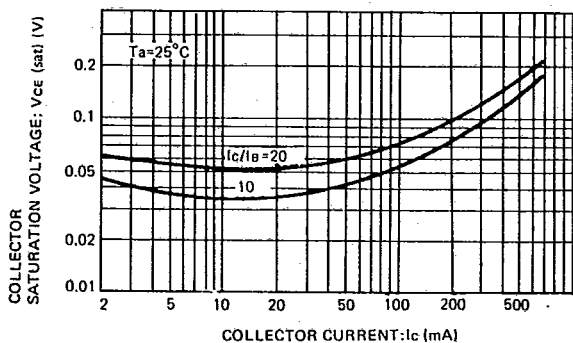


Fig.5 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性

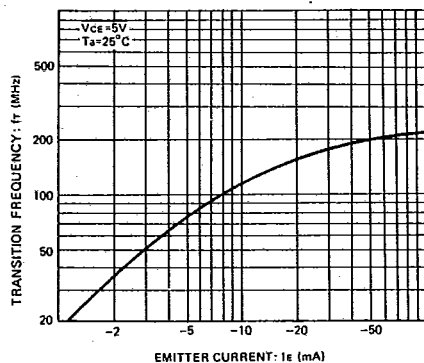


Fig.6 利得帯域幅積—エミッタ電流特性

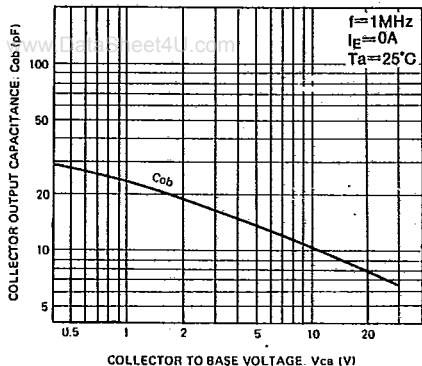


Fig.7 コレクタ出力容量—コレクタ・ベース電圧特性

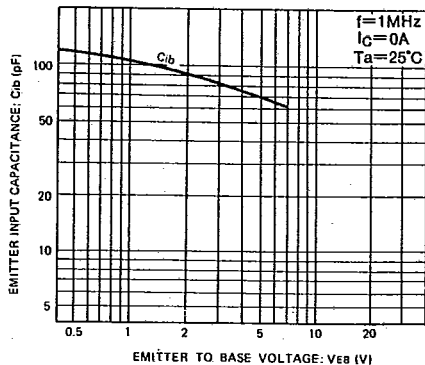


Fig.8 エミッタ入力容量—エミッタ・ベース電圧特性